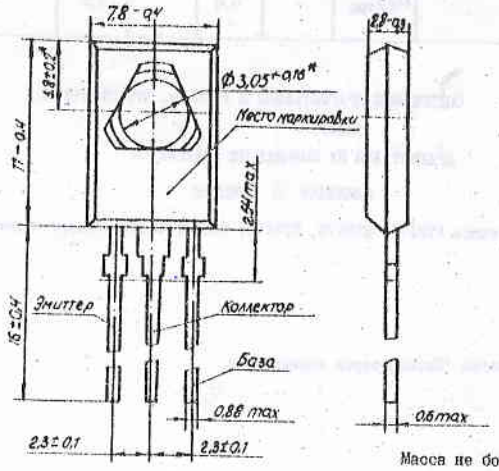
Транзисторы типов КТ817А,КТ817Б, КТ817В,КТ817Г

Э Т И К Е Т К А

Кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n транзисторы типов КТ817А, КТ817Б, КТ817В, КТ817Г в пластмассовом корпусе, предназначенные для применения в клиновых и линейных схемах, узлах и блоках аппаратуры широкого применения, изготавливаемые для нужд народного хозяйства.



Масса не более 1 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $T_{ср}$ = (25±10) °С

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма							
		КТ817А		КТ817Б		КТ817В		КТ817Г	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока ($I_э$ = 1 А, $U_{кб}$ = 2 В)	$h_{21э}$	25	275	25	275	25	275	25	275
Граничное напряжение ($I_э$ = 0,1 А, $t_и$ = 0,3-1 мс), В	$U_{кэ0гр}$	25		45		60		80	
Обратный ток коллектора	$I_{кб0}$								
($U_{кб}$ = 40 В)			100						
($U_{кб}$ = 45 В)					100				
($U_{кб}$ = 60 В)							100		
($U_{кб}$ = 100 В), мкА									100
Обратный ток коллектор-эмиттер ($R_{бэ}$ ≤ 1 кОм)	$I_{кэR}$								
($U_{кб}$ = 40 В)			200						
($U_{кб}$ = 45 В)					200				
($U_{кб}$ = 60 В)							200		
($U_{кб}$ = 100 В), мкА									200

conector.by

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма							
		КТ817А		КТ817Б		КТ817В		КТ817Г	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_К$ = 1 А, $I_Б$ = 0,1 А), В	$U_{кэнас}$		0,6		0,6		0,6		0,6

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ:

Золото - г

ДРАГМЕТАЛЛЫ НА ВЫВОДАХ НЕ СОДЕРЖАТСЯ

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов КТ817А, КТ817Б, КТ817В, КТ817Г соответствуют техническим условиям аА0.336.187 ТУ/02.

Место для
штампа ОТК

Место для штампа "Перепроверка произведена "

Место для
штампа ОТК

conector.by